



סמסונג: תהליכי ייצור לצריכת אנרגי הנמוכה

בועידת טכנולוגית ה-ARM שהתקיימה השבוע בסנטה קלרה, קליפורניה, שלחה סמסונג מסר לתעשיית ייצור השבבים: היא מוכנה לדחיפה הגדולה בטכנולוגיות 32 ננומטר עם k-high.

ביוני מסרה סמסונג כי עסקי הייצור בטכנולוגית 32 ננומטר עוברים לייצור שבבים בצריכת חשמל נמוכה באמצעות טכנולוגית gate-metal/k-high. החברה טענה כי היא הולכת להיות המפעיל הראשון שיהיה מותאם לטכנולוגיה זו.

כעת אומר קואנג קואו לין, מנהל תחום התכנון בחטיבת הייצור של סמסונג, שהיא חטיבת השבבים, כי כעת התהליכים והתכנונים מוכנים. "במונחים של gate-metal/k-high בייצור, אנו נמצאים מעבר לשיא" אמר לין. סמסונג היא חברה במועדון הייצור של יבמ. הדיווחים מהוועידה מסרו כי המועדון נאבק בטכנולוגית הולכים, הייצור טכנולוגית בפיתוח סמסונג של מאמציה כי ואמר הדיווחים את דחה לין. high-k/metal-gate. טוב מאוד. למעשה, סמסונג גילהת עניין רב בתהליך, אמר לין. לקוחות הייצור של סמסונג כולים את אפל, קוואלקום וזילינקס.

השלב הבא במפת הדרכים של סמסונג היא תהליך ייצור ב-28 ננומטר. זהו תהליך בעל צריכת חשמל נמוכה יותר המתבסס על gate-metal/k-high. הן גלובל פאונדריז והן סמסונג מתכוונים להתחיל לפעול בטכנולוגיה זו ברבעון הראשון של 2011. {loadposition content-related}